

## Laboratório sobre Implementação de Sistemas Digitais com VHDL Acesso à Memória Externa na Plataforma de Prototipação XS40/XST-1

Prática: Implementação de uma aplicação que faz acesso à memória externa da plataforma XS40/XST-1

Recursos: Ambiente de Desenvolvimento Active-HDL da Aldec, Inc, CAD Foundation e Ferramentas XSTools e Plataforma XS40/XST-1 da Xess, Inc.

### Parte I – Introdução e Objetivos

Os Laboratórios anteriores serviram para introduzir e compreender o uso da linguagem VHDL na implementação de sistemas digitais.

Este Laboratório tem por objetivo exercitar na prática os conceitos apreendidos pelo uso de recursos que empregam comunicação assíncrona como modo de trocar informações. Trata-se, neste caso, da comunicação entre o FPGA da plataforma de prototipação XS40/XST-1 e a memória estática (SRAM) disponível na mesma plataforma. Esta comunicação assíncrona é bastante simples, uma vez que funciona de forma unidirecional. Especificamente, a memória da XS40/XST-1 não tem como informar que conseguiu ler o dado colocado pelo FPGA no barramento no tempo que o FPGA o disponibilizou. Assim, a temporização de escrita, e sobretudo leitura da memória deve ser cuidadosamente planejada.

Ao final do laboratório, os alunos deverão ter compreendido uma forma particular de operação da comunicação assíncrona, bem como a descrição e implementação de sistemas assíncronos em VHDL. Os objetivos específicos envolvem o desenvolvimento de máquina de estados para controle de operações e a utilização de memórias externas.

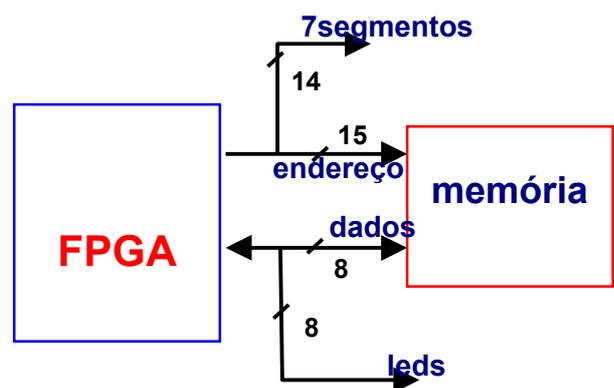
### Parte II - Uma palavra sobre a plataforma de prototipação XS40/XST-1 e o algoritmo de acesso a memória

A plataforma XS40/XST-1 possui um chip de memória RAM estática W24257AK-15, fabricado pela empresa Winbond Electronics Corp. Trata-se de uma memória estática de com organização 32.768 palavras ( $2^{15}$ ) de 8 bits (32Kx8). O acesso se faz via um barramento bidirecional de 8 bits (1 palavra de cada vez), um barramento de endereços de 15 bits e três sinais de controle ativos em zero (CE-“chip enable”, WE-“write enable” e OE-“output enable”).

A plataforma de prototipação XS40/XST-1 usa multiplexação do barramento de endereços da memória com os fios para os mostradores de 7 segmentos, e do barramento de dados com os leds (ver Figura ao lado).

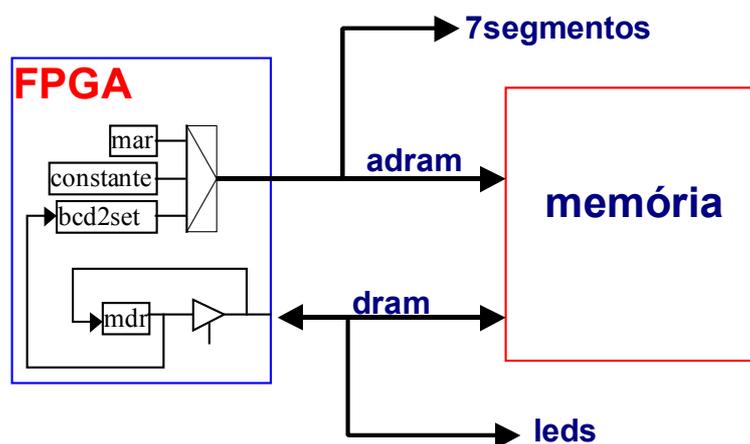
Desta forma, não é possível fazer acesso simultâneo aos recursos de saída (mostradores de 7 segmentos e leds) e a memória.

Mostra-se aqui um algoritmo muito simples de acesso à memória, iniciando por escritas sequenciais (endereço 0 recebe valor, endereço 1 recebe valor+1, etc.), procedendo-se à leitura destes valores após 16 escritas. Este algoritmo pode ser assim descrito:



1. Aguardar o pressionamento da tecla ‘spare’. A seguir, iniciar processo de escrita:  
Registrador **mdr** recebe o valor das chaves dip-switch.  
Registrador **adram** recebe o valor 0.
2. Escrever, no endereço de memória indicado por **adram**, o conteúdo do registrador **mdr**.
3. Incrementar o valor dos registradores **mdr** e **adram**.  
Se o valor de **adram** for maior que 16, ir para o passo 4. Senão, voltar para o passo 2<sup>1</sup>.
4. Esperar que seja pressionada a tecla ‘spare’. A seguir, zerar o registrador **adram**.
5. Ler o conteúdo de memória apontado por **adram** armazenando-o no registrador **mdr**.
6. Incrementar o registrador **adram**. Exibir o valor nos displays de sete-segmentos. Se o valor de **adram** for maior que 16 passar para o passo 7. Senão, voltar ao passo 5<sup>2</sup>.
7. Terminar a execução, reiniciando o processo de escrita apenas quando for pressionada a tecla ‘reset’.

### Parte III - Análise do circuito



Cada passo do algoritmo apresentado anteriormente pode ser implementado como um estado da máquina de estados de controle (S1 a S7), descrita na **Parte I** do código VHDL que aparece mais adiante nesta Seção.

O barramento *adram* (endereçamento da memória e mostradores de 7 segmentos) pode receber dados de 3 fontes distintas: registrador *mar*, quando desejo endereçar a memória; constante, quando desejo exibir uma constante nos displays; e o valor de *mdr* convertido para 7-segmentos, quando desejo exibir o valor lido da memória. A escolha de qual fonte será utilizada pelo *adram* é feita através de uma atribuição concorrente. O registrador *mar* tem por função armazenar e incrementar o endereço que vai ser utilizado para acesso à memória. O funcionamento dos barramentos *adram* e *mar* estão descritos na “**PARTE 2**” do código VHDL.

O barramento *dram* pode ser tanto entrada como saída, dependendo da ação efetuada sobre a memória. O registrador *mdr* tem por objetivo armazenar o valor contido nas chaves (*dipsw*), ou incrementar seu valor ou ser inicializado com o valor de *dram* (quando se lê da memória). Quando

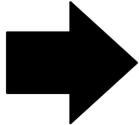
<sup>1</sup> Os passos 2 e 3 escrevem seqüencialmente na memória, a partir do endereço de memória 0000H, o valor indicado pelas chaves, incrementado este endereço de 1 a cada novo endereço.

<sup>2</sup> Os passos 5 e 6 lêem seqüencialmente da memória, a partir do endereço de memória 0000H, exibindo cada valor lido nos mostradores de 7 segmentos.

se está escrevendo na memória (estados S2 e S3) *dram* recebe *mdr*, senão *dram* fica em alta impedância. Isto permite que dados provenientes da memória seja escritos em *mdr*. Os barramentos *dram* e *mdr* têm sua funcionalidade descrita na “**PARTE 3**” do código VHDL.

Como dito antes, A memória tem 3 sinais de controle ativos em zero: *OE*, para indicar leitura; *WE*, para indicar escrita; e *CE* para habilitar a pastilha de memória a funcionar (para leitura e/ou escrita). A geração destes sinais está descrita na “**PARTE 4**” do código VHDL.

## Código VHDL



- ◆ **Buscar o arquivo com a descrição VHDL do projeto inicial em <http://www.inf.pucrs.br/~calazans/undergrad/laborg/acao.vhd>. Iniciar um novo projeto no FOUNDATION. Neste laboratório não será utilizado o simulador Active-HDL. O código VHDL abaixo contém apenas o módulo principal.**
- ◆ **Complete a descrição, não esquecendo de colocar o arquivo UCF no projeto (ver em anexo, ao final deste texto).**
- ◆ **Sugestão: liste os sinais necessários antes de iniciar o projeto.**
- ◆ **Uma vez a descrição VHDL completa, faça a síntese do hardware e verifique se o circuito está funcionando corretamente.**
- ◆ **Depois desta etapa **introdutória**, há o trabalho propriamente dito, que é **modificar** este projeto.**

```
-----
-- Entidade acc_mem, grava e le da memoria
-----

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
use work.soma.all;

entity acc_mem is -- importante não alterar – comunicação com o arquivo UCF !!!
port
  ( dipsw: in std_logic_vector(8 downto 1); -- DIP switches
    spareb: in std_logic; -- SPARE pushbutton
    resetb: in std_logic; -- RESET pushbutton

    dram: inout reg8;          -- XS Board Ram data
    adram: out reg15;         -- XS Board Ram Adress

    oe: out std_logic; -- Output enable for all RAMs (negado)
    ce: out std_logic; -- Chip enable (negado)
    we: out std_logic; -- Read/Write (negado)

    clock: in std_logic -- Clock de 12Mhz (pino 13 do FPGA)
  );
end acc_mem;

architecture acc_mem of acc_mem is

Aqui colocar os sinais necessários. Os componentes já estão no package.

begin

  U1 : OSC4 port map( mapear os pinos ao sinais previamente declarados );
  U2 : debounce port map( mapear os pinos ao sinais previamente declarados );
  U3 : display port map( mapear os pinos ao sinais previamente declarados );
```



U4 : display port map( **mapear os pinos ao sinais previamente declarados** );

<pre> ----- geração do proximo estado ----- process(clock,resetb) begin if (resetb='0') then EA&lt;=S1; elsif clock'event and clock='1' then EA&lt;=PE; end if; end process;  ---- maquina de estados para a escrita/leitura na memoria ---- ---- controlada pela chave spare_b e o EA ----- process(spareCK, EA) begin case(EA) is when S1 =&gt; if spareCK='0' then PE&lt;=S2; else PE&lt;=EA; end if; when S2 =&gt; PE&lt;=S3; when S3 =&gt; if mar(4)='1' then PE&lt;=S4; else PE&lt;=S2; end if; when S4 =&gt; if spareCK='0' then PE&lt;=S5; else PE&lt;=EA; end if; when S5 =&gt; if mar(4)='0' then PE&lt;=S6; else PE&lt;=S7; end if; when S6 =&gt; if spareCK='0' then PE&lt;=S5; else PE&lt;=EA; end if; when S7 =&gt; PE&lt;=s7; end case; end process; </pre>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="color: blue; text-align: center;"><b>Tarefa 1: Desenhe esta máquina de</b></p> </div> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"><b>PARTE 1</b></p>
<pre> -- zera o mar nos estados S1 e S4, e o incrementa nos estados S3 e S5 process(clock,resetb,EA) begin if (EA=S1 or EA=S4) then mar&lt;= (others=&gt;'0'); elsif clock'event and clock='1' then if EA=S3 or EA=S5 then mar&lt;=mar+1; end if; end if; end process;  -- implementa o multiplexador para seleção de quem vai em adram with EA select adram &lt;= mar when S2   S3   S5, "111011111110111" when S4, not( setseg1(6 downto 0) &amp; setseg2(7 downto 0) ) when S1   S6   S7; </pre>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"><b>PARTE 2</b></p>
<pre> -- implementa o registrador mdr, inserindo nele o valor lido, no estado S5 process(clock,EA) begin if clock'event and clock='1' then if EA=S1 then mdr&lt;=not dipsw; elsif EA=S3 then mdr&lt;=mdr+1; elsif EA=S5 then mdr&lt;=dram; -- captura dado vindo da memoria end if; end if; end process;  -- implementa o tri-state, ou seja, coloca dados quando for escrever with EA select dram &lt;= mdr when S2   S3, "ZZZZZZZ" when others; </pre>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"><b>PARTE 3</b></p>

```
-- le da memoria apenas no estado S5
OE <= '0' when EA=S5 else '1';
-- escreve na memoria apenas no estado S2
WE <= '0' when EA=S2 else '1';
-- habilita a memoria apenas nos estados S2 e S5
CE <= '0' when EA=S5 or EA=S2 else '1';
end acc_mem;
```

### Parte IV - Implementação de uma nova versão do algoritmo de leitura

Faça as modificações abaixo no projeto, sintetize e teste a nova versão:

- No início, ao invés de ler apenas uma informação das chaves, leia três:
  - Valor inicial a ser gravado na memória -  $v0$ ;
  - Passo entre dois elementos consecutivos -  $step$ .
  - Número de elementos a gravar -  $nb$ ;

Endereço	Conteúdo da Memória	
	Versão original	Versão modificada
0	key	$v0$
1	key+1	$v0+step$
2	key+2	$v0+2*step$
3	key+3	$v0+3*step$
4	key+4	$v0+4*step$
5	key+5	$v0+5*step$
6	key+6	$v0+6*step$
...	...	
15	key+15	

#### Dicas para o correto funcionamento:

1. É necessário acrescentar apenas 2 (dois) estados adicionais na máquina de estado, para armazenamento das variáveis. No reset armazena-se o número de elementos, na primeira pressionada de *spare* o passo e na segunda pressionada de *spare* o valor de início de contagem.
2. Resumo das alterações necessárias no código:
  - a) Declarar mais dois estados;
  - b) Nos estados S3 e S5 fazer comparação com o número de elementos (processo da máquina de estados);
  - c) No comando “with EA select ...” indicar que é para utilizar os sete segmentos nos estados acrescentados;
  - d) Modificar o processo que atribui valor a *mdr*, inserindo também os estados adicionais. Uma sugestão é:

```
....
if EA=S1 then    n <=not dipsw; mdr<=not dipsw;
elsif EA=E1 then    step <=not dipsw; mdr<=not dipsw;
elsif EA=E2 then    mdr <=not dipsw;
....
```

**ARQUIVO COM OS PINOS DE CONEXÃO DO FPGA À PLACA (ARQUIVO UCF)**

<b>#Arquivo UCF</b>		<b># SRAM DATA</b>	
#		NET dram<0>	LOC=P41;
NET clock	LOC=P13;	NET dram<1>	LOC=P40;
#		NET dram<2>	LOC=P39;
<b># DIP SWITCH CONNECTIONS</b>		NET dram<3>	LOC=P38;
NET dipsw<1>	LOC=P7;	NET dram<4>	LOC=P35;
NET dipsw<2>	LOC=P8;	NET dram<5>	LOC=P81;
NET dipsw<3>	LOC=P9;	NET dram<6>	LOC=P80;
NET dipsw<4>	LOC=P6;	NET dram<7>	LOC=P10;
NET dipsw<5>	LOC=P77;	#	
NET dipsw<6>	LOC=P70;	<b># SRAM ADDRESS</b>	
NET dipsw<7>	LOC=P66;	NET adram<0>	LOC=P3;
NET dipsw<8>	LOC=P69;	NET adram<1>	LOC=P4;
#		NET adram<2>	LOC=P5;
<b># PUSHBUTTON SWITCH CONNECTIONS</b>		NET adram<3>	LOC=P78;
NET SPAREB	LOC=P67;	NET adram<4>	LOC=P79;
NET RESETB	LOC=P37;	NET adram<5>	LOC=P82;
#		NET adram<6>	LOC=P83;
#		NET adram<7>	LOC=P84;
<b># SRAM CONTROLLERS</b>		NET adram<8>	LOC=P59;
NET ce	LOC=P65;	NET adram<9>	LOC=P57;
NET oe	LOC=P61;	NET adram<10>	LOC=P51;
NET we	LOC=P62;	NET adram<11>	LOC=P56;
		NET adram<12>	LOC=P50;
		NET adram<13>	LOC=P58;
		NET adram<14>	LOC=P60;

**Parte VI - A Fazer e a Entregar**

- O projeto completo na sua versão modificada compactado pelo Foundation (opção de menu Design → Archive Design... do Ambiente Active-HDL), com formas de onda salvas em arquivo dentro do projeto;
- Relatório do projeto, contendo o diagrama de transição de estados da **Parte 1** do VHDL;
- Mostrar o projeto funcionando ao professor dentro de duas semanas.

Percentuais de nota atribuídos às Atividades:

Item Avaliado	Percentual
<b>Projeto completo e simulações</b>	<b>50%</b>
<b>Relatório</b>	<b>30%</b>
<b>Demonstração do projeto, funcional ou não, ao professor, em aula</b>	<b>20%</b>